





	<h2 style="color: red;">SI1013R-T1-GE3</h2>
	Hersteller-Teilenummer: SI1013R-T1-GE3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 20V 350MA SC-75A
	Datenblätter:  SI1013R-T1-GE3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 92192 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
	Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI1013R-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 350MA SC-75A
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	92192 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	33 Weeks
detaillierte Beschreibung	P-Channel 20V 350mA (Ta) 150mW (Ta) Surface
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SC-75A
Supplier Device-Gehäuse	SC-75A
Verlustleistung (max)	150mW (Ta)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	350mA (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.2 Ohm @ 350mA, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	450mV @ 250µA (Min)
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	1.5nC @ 4.5V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.8V, 4.5V
Vgs (Max)	±6V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI1013R-T1-GE3TR

SI1013R-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI1013R-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI1013R-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI1013R-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI1013R-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 350MA SC-75A</p>	 <p>SI1013X-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 350MA SC89-3</p>	 <p>SI1013R-T1 VISHAY SI1013R-T1 VISHAY</p>	 <p>SI1013X-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 350MA SC89-3</p>
 <p>SI1013R-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 350MA SC-75A</p>	 <p>SI1013X VISHAY SI1013X VISHAY</p>	 <p>SI1013R TI SI1013R TI</p>	 <p>SI1013X-T1 VISHAY SI1013X-T1 VISHAY</p>

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ⊛ SI1000-C-GM | ↔ SI1002-C-GMR | ⇒ SI1003-C-GM | D SI1011X-T1-GE3 | ↔ SI1011X-T1-GE3 |
| ↔ SI1012CR-T1-GE3 | ⊛ SI1012CR-T1-GE3 | D SI1012R-T1 | ⇒ SI1012R-T1-E3 | ↔ SI1012R-T1-E3 |
| ⊛ SI1012R-T1-GE3 | ↔ SI1012R-T1-GE3 | ⊛ SI1012X-T1 | ↔ SI1012X-T1-E3 | ↔ SI1012X-T1-E3 |
| D SI1012X-T1-GE3 | ⊛ SI1012X-T1-GE3 | ↔ SI1013CX-T1-GE3 | ⊛ SI1013CX-T1-GE3 | ↔ SI1013R-T1 |
| ⇒ SI1013R-T1-E3 | ↔ SI1013R-T1-E3 | ⊛ SI1013R-T1-GE3 | ↔ SI1013X-T1 | ↔ SI1013X-T1-E3 |
| ↔ SI1013X-T1-E3 | ⇒ SI1013X-T1-GE3 | D SI1013X-T1-GE3 | ⊛ SI1016CX-T1-GE3 | ↔ SI1016CX-T1-GE3 |
| ⊛ SI1016X-T1-E3 | D SI1016X-T1-E3 | ⇒ SI1016X-T1-GE3 | ↔ SI1016X-T1-GE3 | ↔ SI1016X2-T1-GE3 |
| ↔ SI1021R-T1 | ⊛ SI1021R-T1-E3 | ↔ SI1021R-T1-E3 | ⇒ SI1022R-T1 | ↔ SI1022R-T1-E3 |
| ⊛ SI1022R-T1-E3 | ↔ SI1022R-T1-GE3 | ⊛ SI1022R-T1-GE3 | D SI1022R-T1-E3 | ↔ SI1023CX-T1-GE3 |
| ↔ SI1023CX-T1-GE3 | ⊛ SI1023X-T1 | ↔ SI1023X-T1-E3 | ⊛ SI1023X-T1-E3 | ↔ SI1023X-T1-GE3 |

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited